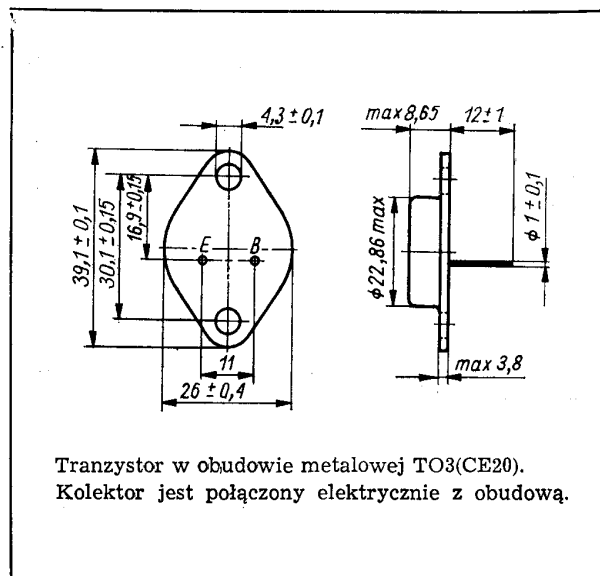


Tranzystory germanowe stopowe dużej mocy małej częstotliwości. Są przeznaczone do stosowania we wzmacniaczach akustycznych i przetwornicach. Do układów przeciwsobnych tranzystory są dobierane parami.



DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Typ	ADP670	ADP671	ADP672	
Napięcie kolektor-baza	$-U_{CB0}$	20	30	60 V
Napięcie kolektor-emiter	$-U_{CES}$	20	30	60 V
Napięcie emiter-baza	$-U_{EB0}$	10	10	10 V
Prąd kolektora	$-I_C$	1,5	1,5	1,5 A
Prąd szczytowy kolektora	$-I_{CM}$	3	3	3 A
Prąd szczytowy bazy	$-I_{BM}$	0,5	0,5	0,5 A
Prąd emitera	$-I_E$	1,6	1,6	1,6 A
Prąd szczytowy emitera	$-I_{EM}$	3,3	3,3	3,3 A
Temperatura złącza	t_j	348 K (75°C)		
Zakres temperatury składowania	t_{etg}	248...328 K (-25...+55°C)		
Moc strat kolektora przy $t_{case} = 298$ K (25°C)	P_C	10	10	10 W

SWW 1156-231

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna

złącze-otoczenie	$R_{th(j-a)}$	33	33	33	K/W
złącze-obudowa	$R_{th(j-c)}$	5	5	5	K/W

TRANZYSTOR ADP670

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K
(+25°C)

Współczynnik

wzmocnienia prądowego

przy $-I_C = 0,3$ A,

$-U_{CE} = 6$ V

przy $-I_C = 3$ A,

$-U_{CE} = 1$ V

Prąd zerowy kolektora

przy $-U_{CB} = 12$ V

przy $-U_{CB} = 12$ V,

$t_{amb} = 343$ K (70°C)

Prąd zerowy emitera

przy $-U_{EB} = 6$ V

Napięcie przebicia kolektor-baza

przy $-I_C = 500$ μ A,

$I_E = 0$

Napięcie przebicia kolektor-emiter

przy $-I_C = 500$ μ A,

$R_{BE} = 0$

Napięcie przebicia emiter-baza

przy $-I_E = 100$ μ A,

$-I_C = 0$

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K

(25°C)

Częstotliwość graniczna

przy $-U_{CB} = 6$ V,

$-I_C = 0,3$ A

Stosunek współczynników wzmocnienia prądowego dobranych par*

przy $-U_{CE} = 6$ V,

$-I_C = 0,3$ A

przy $-U_{CE} = 1$ V,

$-I_C = 3$ A

min. typ. maks.

30 — 200 —

10 — — —

— 20 100 μ A

— 0,7 2,5 mA

— 15 50 μ A

30 — — V

30 — — V

10 — — V

min. typ. maks.

100 180 — kHz

— — 1,3 —

— — 1,3 —

* Tranzystory dobiera się w pary na życzenie odbiorcy określone w zamówieniu.

TRANZYSTOR ADP671

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)	min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmocnienia prą- dowego				
przy $-I_C = 0,3 \text{ A}$, $-U_{CE} = 6 \text{ V}$	h_{21E}	30	—	200
przy $-I_C = 3 \text{ A}$, $-U_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{21E}	10	—	—
Prąd zerowy kolek- tora				
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$ $-I_{CB0}$		—	20	100 μA
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$, $t_{amb} = 343 \text{ K}$ (70°C) $-I_{CB0}$		—	0,7	2,5 mA
Prąd zerowy emitera				
przy $-U_{EB} = 6 \text{ V}$ $-I_{EB0}$		—	15	50 μA
Napięcie przebicia kolektor-baza				
przy $-I_C = 500 \mu\text{A}$, $I_E = 0$	$-U_{(BR)CB0}$	20	—	— V
Napięcie przebicia kolektor-emiter				
przy $-I_C = 500 \mu\text{A}$, $R_{BE} = 0$	$-U_{(BR)CES}$	20	—	— V
Napięcie przebicia emiter-baza				
przy $-I_E = 100 \mu\text{A}$, $-I_C = 0$	$-U_{(BR)EB0}$	10	—	— V

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)	min.	typ.	maks.	
Częstotliwość gra- niczna				
przy $-U_{CB} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,3 \text{ A}$	f_T	100	180	— kHz
Stosunek współczyn- ników wzmocnienia prądowego*				
przy $-U_{CE} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,3 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3 —
przy $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 3 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3 —

TRANZYSTOR ADP672

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)	min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmocnienia prą- dowego				
przy $-I_C = 0,3 \text{ A}$, $-U_{CE} = 6 \text{ V}$	h_{21E}	30	—	200
przy $-I_C = 3 \text{ A}$, $-U_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{21E}	10	—	—
Prąd zerowy kolek- tora				
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$ $-I_{CB0}$		—	20	100 μA
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$, $t_{amb} = 343 \text{ K}$ (70°C) $-I_{CB0}$		—	0,7	2,5 mA

Prąd zerowy emitera

przy $-U_{EB} = 6 \text{ V}$ $-I_{EB0}$ — 18 50 μA

Napięcie przebicia

kolektor—baza

przy $-I_C = 500 \mu\text{A}$, $I_E = 0$ $-U_{(BR)CB0}$ 60 — — V

Napięcie przebicia

kolektor—emiter

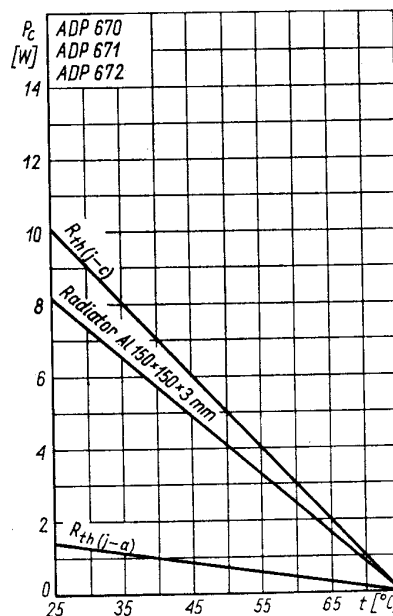
przy $-I_C = 500 \mu\text{A}$, $R_{BE} = 0$ $-U_{(BR)CES}$ 60 — — V

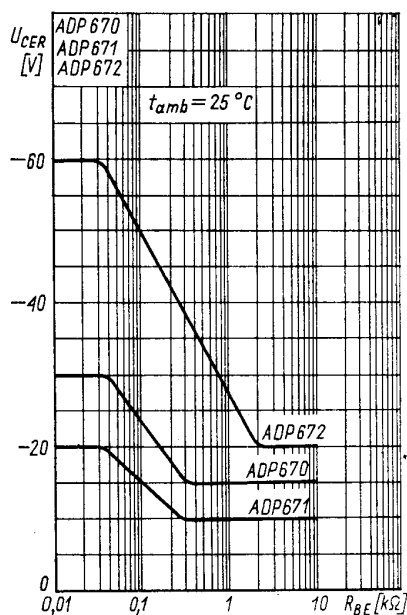
Napięcie przebicia

emiter—baza

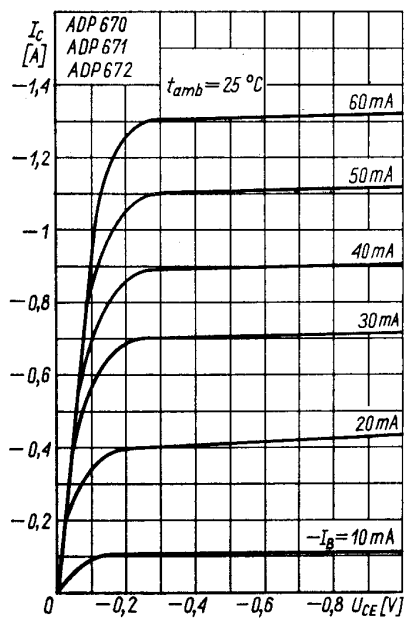
przy $-I_E = 100 \mu\text{A}$, $-I_C = 0$ $-U_{(BR)EB0}$ 10 — — V

Parametry dynamiczne

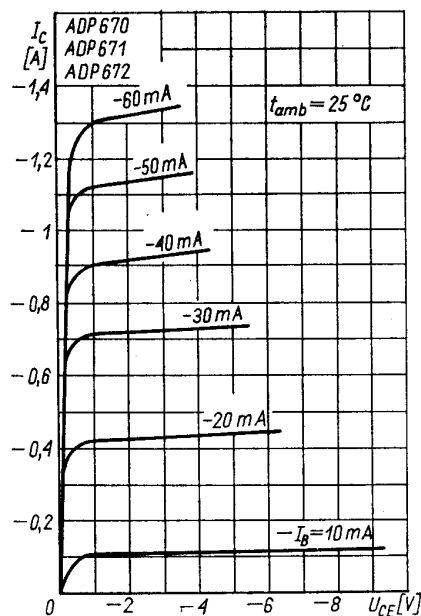
przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$
(25°C)Częstotliwość gra-
nicznaprzy $-U_{CB} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,3 \text{ A}$ f_T 100 180 — kHz Stosunek współczyn-
ników wzmocnienia
prądowego dobrze-
nych par*przy $-U_{CE} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,3 \text{ A}$ $\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$ — — 1,3 —przy $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 3 \text{ A}$ $\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$ — — 1,3 —* Tranzystory dobiera się w pary na życzenie odbiorcy określo-
ne w zamówieniu.Zależność temperaturowa mocy strat $P_c = f(t)$



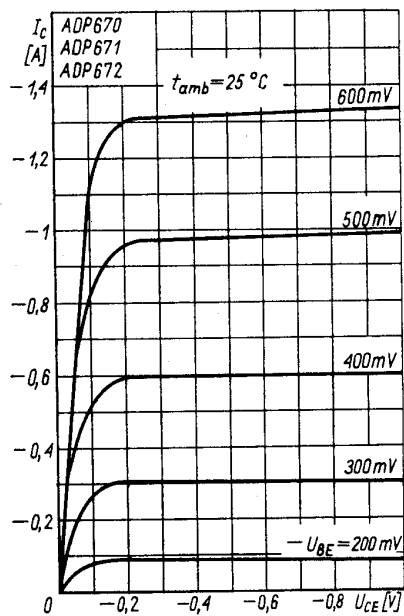
Zależność napięcia kolektor-emiter od rezystancji emiter-baza $U_{CER} = f(R_{BE})$



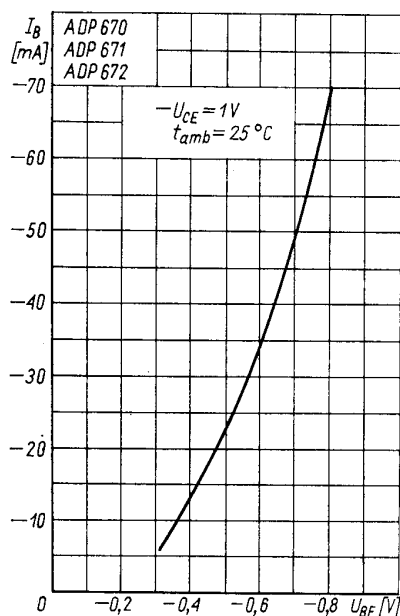
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr



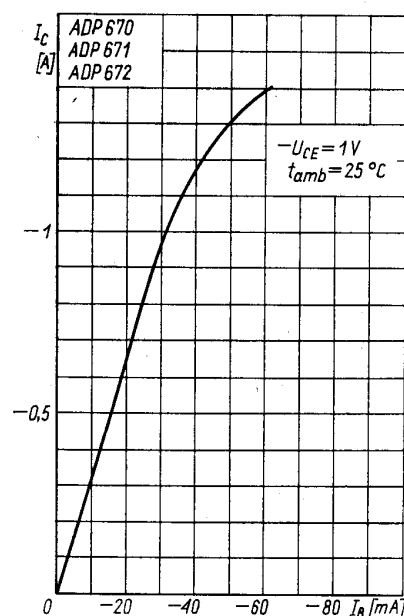
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr



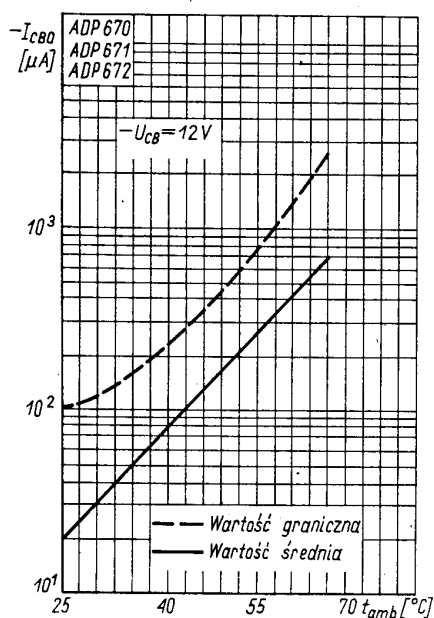
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; U_{BE} — parametr



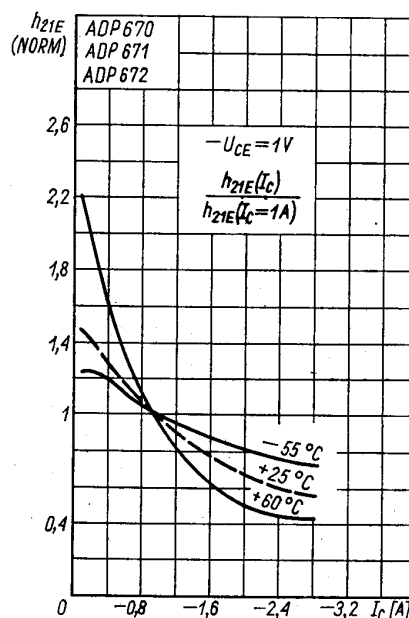
Charakterystyka wejściowa $I_B = f(U_{BE})$; U_{CE} — parametr



Charakterystyka przejściowa $I_C = f(I_B)$



Zależność temperaturowa prądu zerowego $I_{CB0} = f(t_{amb})$



Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego znormalizowanego od prądu kolektora

PRODUCENT

UNITRA
CEMI

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓŁPRZEWODNIKÓW „TEWA”
ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR

UNITRA
UNIZET

BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERRADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435